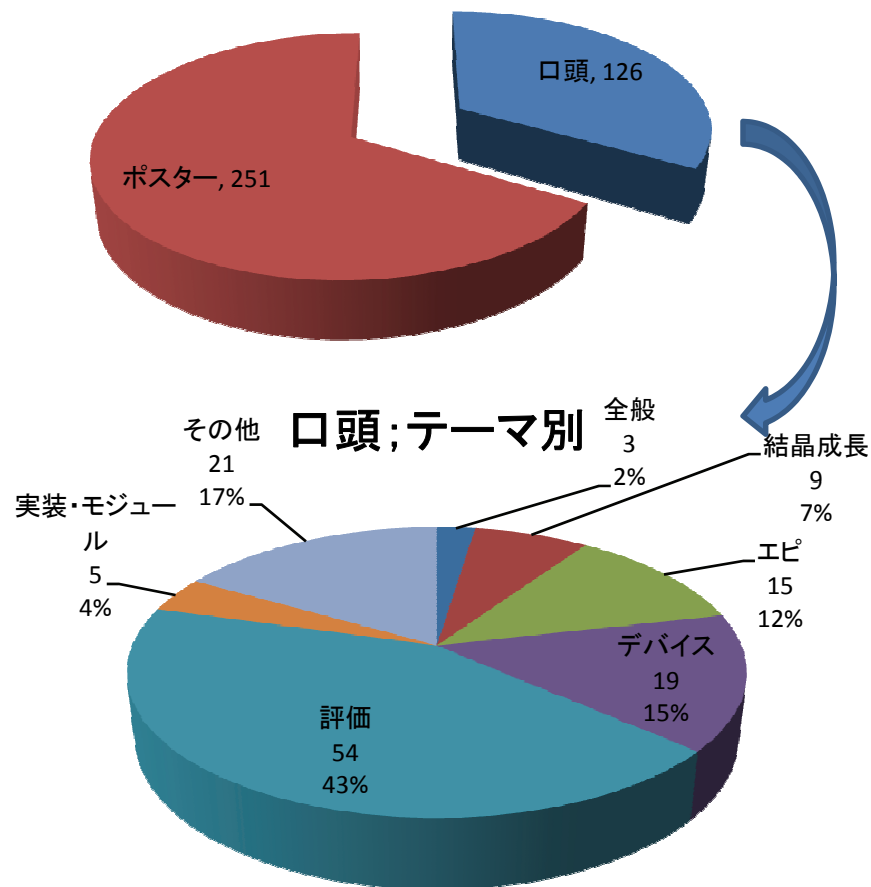


ICSCRM2011出張報告(概要)

■ 統計情報

総発表件数;377件



		口頭
全般	全般	3
結晶成長	昇華法	3
	ガス法	1
	溶液	2
	理論計算(昇華・溶液)	1
	その他(FZ, Template)	2
エピ	エピ	5
	低オフ角,3C	5
	塩素添加,etc.	5
デバイス	MOSFET	5
	JFET	1
	BJT	2
	PIN	5
	IGBT	1
	Thyristor	4
	集積回路	1
評価	界面	20
	結晶欠陥・点欠陥	20
	劣化,転位と信頼性	5
	キャリアライフタイム	4
	金属不純物	5
実装・モジュール	Hibrid,高温,コンタクト	5
その他	GaN	2
	III-V	1
	グラフェン	12
	センサ・LED	5
	その他(ヘテロ)	1
総計		126